

MITSUBISHI IGBT MODULES

CM75E3U-24F

HIGH POWER SWITCHING USE

CM75E3U-24F



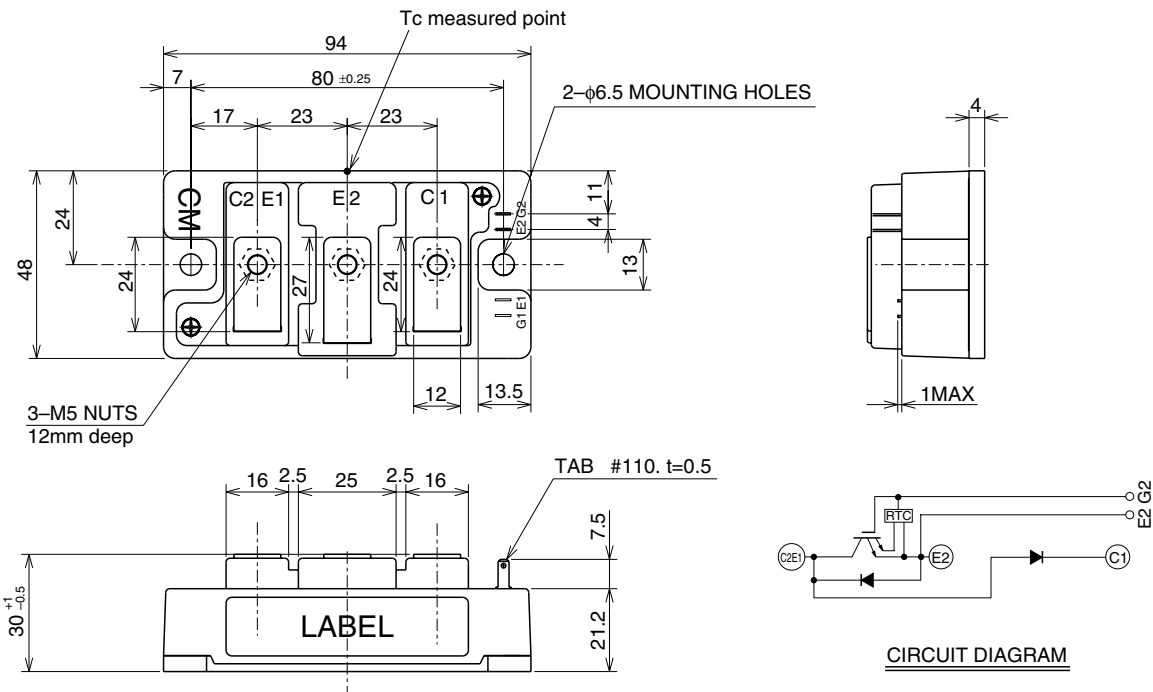
- Ic 75A
- VCES 1200V
- Insulated Type
- 1-element in a pack

APPLICATION

Brake

OUTLINE DRAWING & CIRCUIT DIAGRAM

Dimensions in mm



CM75E3U-24F

HIGH POWER SWITCHING USE

MAXIMUM RATINGS (T_j = 25°C)

Symbol	Parameter	Conditions	Ratings	Unit
V _{CES}	Collector-emitter voltage	G-E Short	1200	V
V _{GES}	Gate-emitter voltage	C-E Short	±20	V
I _C	Collector current	T _C = 25°C	75	A
I _{CM}		Pulse (Note 2)	150	A
I _E (Note 1)	Emitter current	T _C = 25°C	75	A
I _{EM} (Note 1)		Pulse (Note 2)	150	A
P _C (Note 3)	Maximum collector dissipation	T _C = 25°C	450	W
V _{RRM}	Repetitive peak reverse voltage	Clamp diode part	1200	V
I _F	Forward current	T _C = 25°C	75	A
I _{FM}		Pulse Clamp diode part (Note 2)	150	A
T _j	Junction temperature		−40 ~ +150	°C
T _{stg}	Storage temperature		−40 ~ +125	°C
V _{iso}	Isolation voltage	Charged part to base plate, AC 1 min.	2500	V
—	Torque strength	Main Terminal M5	2.5 ~ 3.5	N • m
—		Mounting holes M6	3.5 ~ 4.5	N • m
—	Weight	Typical value	310	g

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_j = 25°C)

Symbol	Parameter	Test conditions	Limits			Unit
			Min.	Typ.	Max.	
I _{CES}	Collector cutoff current	V _{CE} = V _{CES} , V _{GE} = 0V	—	—	1	mA
V _{GE(th)}	Gate-emitter threshold voltage	I _C = 7.5mA, V _{CE} = 10V	5	6	7	V
I _{GES}	Gate leakage current	V _{GE} = V _{CES} , V _{CE} = 0V	—	—	20	μA
V _{CE(sat)}	Collector-emitter saturation voltage	T _j = 25°C	—	1.8	2.4	V
		T _j = 125°C	—	1.9	—	
C _{ies}	Input capacitance	V _{CE} = 10V V _{GE} = 0V	—	—	29	nF
C _{oes}	Output capacitance		—	—	1.3	nF
C _{res}	Reverse transfer capacitance		—	—	0.75	nF
Q _G	Total gate charge	V _{CC} = 600V, I _C = 75A, V _{GE} = 15V	—	825	—	nC
t _{d(on)}	Turn-on delay time	V _{CC} = 600V, I _C = 75A V _{GE1} = V _{GE2} = 15V R _G = 4.2Ω, Inductive load switching operation I _E = 75A	—	—	100	ns
t _r	Turn-on rise time		—	—	50	ns
t _{d(off)}	Turn-off delay time		—	—	400	ns
t _f	Turn-off fall time		—	—	300	ns
t _{rr} (Note 1)	Reverse recovery time		—	—	150	ns
Q _{rr} (Note 1)	Reverse recovery charge		—	3.1	—	μC
V _{EC} (Note 1)	Emitter-collector voltage	I _E = 75A, V _{GE} = 0V	—	—	3.2	V
R _G	External gate resistance		4.2	—	42	Ω
R _{th(j-c)Q}	Thermal resistance*1	IGBT part	—	—	0.28	°C/W
R _{th(j-c)R}		FWDi part	—	—	0.47	°C/W
R _{th(j-c)Q}	Thermal resistance	T _C measured point is just under the chips	—	—	0.22*3	°C/W
V _{FM}	Forward voltage drop	I _F = 75A, Clamp diode part	—	—	3.2	V
t _{rr}	Reverse recovery time	I _F = 75A V _{CC} = 600V, V _{GE1} = V _{GE2} = 15V R _G = 4.2Ω, Inductive load switching operation, Clamp diode part	—	—	150	ns
Q _{rr}	Reverse recovery charge		—	3.1	—	μC
R _{th(j-c)R}	Thermal resistance*1	Clamp diode part	—	—	0.47	°C/W
R _{th(c-f)}	Contact thermal resistance	Case to fin, Thermal compound applied*2 (1/2 module)	—	0.07	—	°C/W

Note 1. I_E, V_{EC}, t_{rr}, Q_{rr}, die/dt represent characteristics of the anti-parallel, emitter to collector free-wheel diode (FWDi).

2. Pulse width and repetition rate should be such that the device junction temp. (T_j) does not exceed T_{jmax} rating.

3. Junction temperature (T_j) should not increase beyond 150°C.

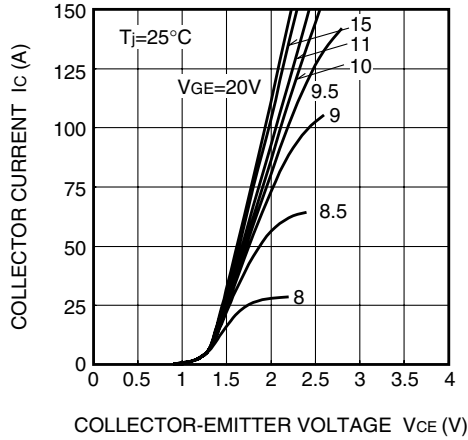
*1 : T_C measured point is indicated in OUTLINE DRAWING.

*2 : Typical value is measured by using Shin-etsu Silicone "G-746".

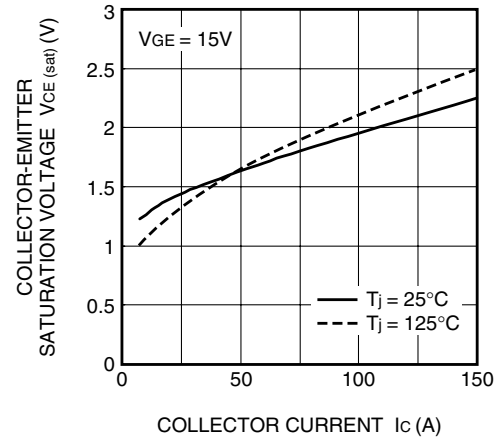
*3 : If you use this value, R_{th(f-a)} should be measured just under the chips.

PERFORMANCE CURVES

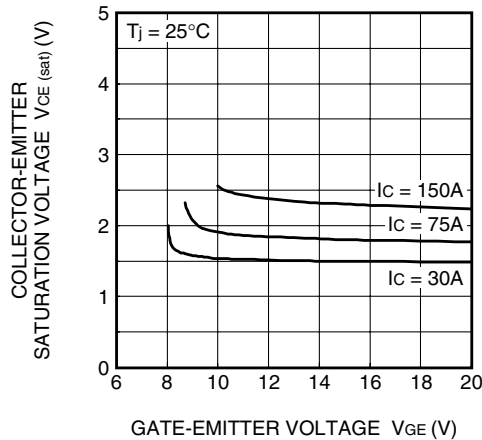
OUTPUT CHARACTERISTICS
(TYPICAL)



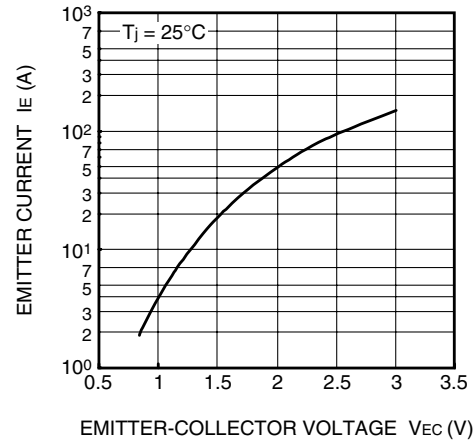
COLLECTOR-EMITTER SATURATION
VOLTAGE CHARACTERISTICS
(TYPICAL)



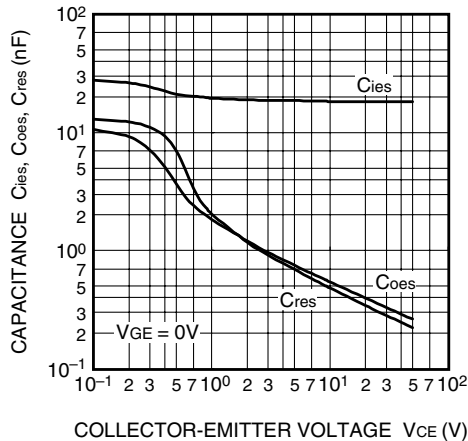
COLLECTOR-EMITTER SATURATION
VOLTAGE CHARACTERISTICS
(TYPICAL)



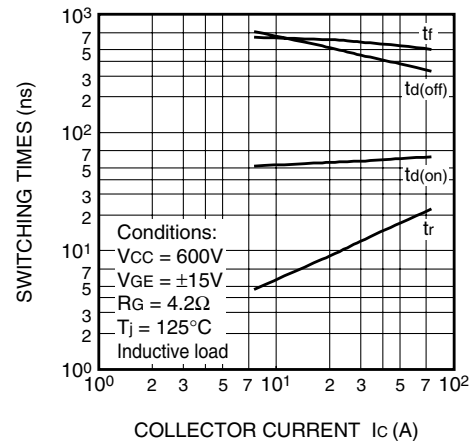
FREE-WHEEL DIODE AND CLAMP DIODE
FORWARD CHARACTERISTICS
(TYPICAL)



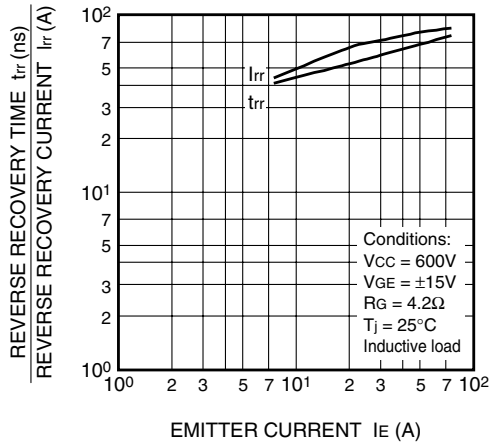
CAPACITANCE- V_{CE}
CHARACTERISTICS
(TYPICAL)



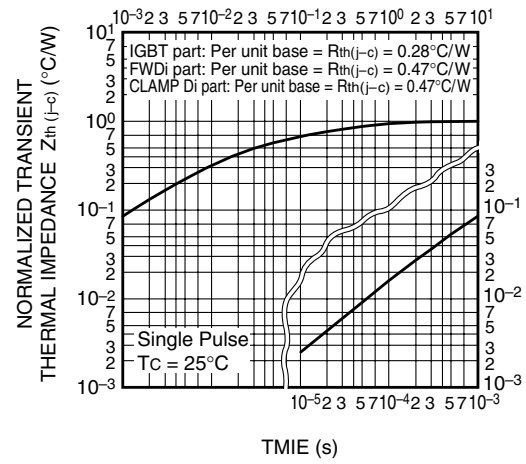
HALF-BRIDGE
SWITCHING CHARACTERISTICS
(TYPICAL)



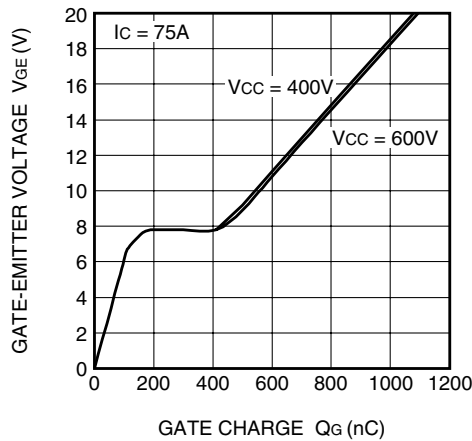
REVERSE RECOVERY CHARACTERISTICS
OF CLAMP DIODE
(TYPICAL)



TRANSIENT THERMAL
IMPEDANCE CHARACTERISTICS
(IGBT part & FWDi part & CLAMP DIODE part)



GATE CHARGE
CHARACTERISTICS
(TYPICAL)





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.